

Silicon Diode

BYV38

1000V / 2A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BYV 37 · BYV 38

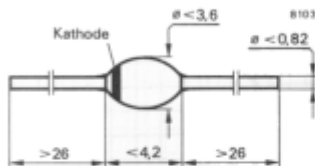
Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schneller „soft recovery“ Gleichrichter

Features:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse
- Kleiner Sperrstrom
- Soft recovery Verhalten
- ● Auch als "Gütebestätigtes Bauelement" nach ESA-SCC 5000 lieferbar

Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse
SOD 57
Gewicht max. 0,5 g

Bestempfung: Klartext

Absolute Grenzwerte

		BYV 37	BYV 38	
Sperrspannung	U_R	800	1000	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	50		A
Durchlaßstrom, Mittelwert, Fig. 2, 5	I_{FAV}	2		A
Sperrschichttemperatur	T_j	175		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65...+ 175		°C

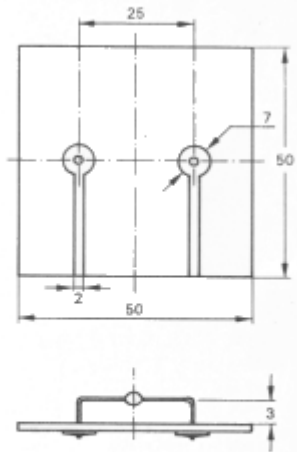
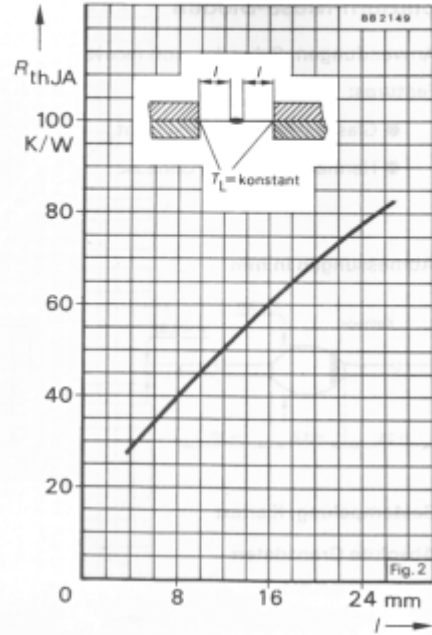
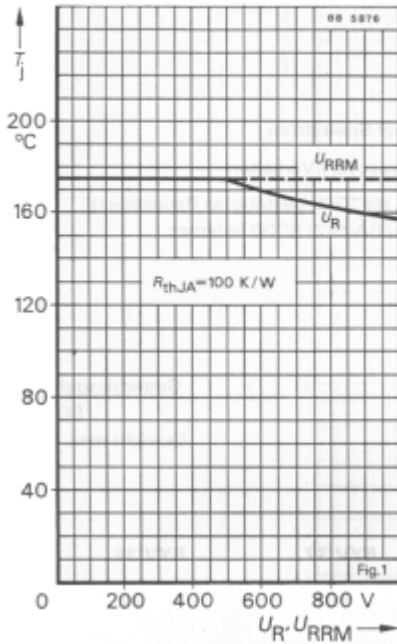
Maximale Wärmewiderstände

Sperrschicht-Umgebung $l = 10 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	Fig. 2	R_{thJA}	45	K/W
auf Leiterplatte im Raster 25 mm	Fig. 3	R_{thJA}	100	K/W

Kenngößen

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 1 \text{ A}$	U_F		1,0	1,1	V
Sperrstrom U_R	I_R		1	5	μA
$U_R, T_j = 150 \text{ °C}$	I_R		60	150	μA
Rückwärtserholzeit $I_F = 0,5 \text{ A}, I_R = 1 \text{ A}, i_R = 0,25 \text{ A}$	t_{rr}			300	ns

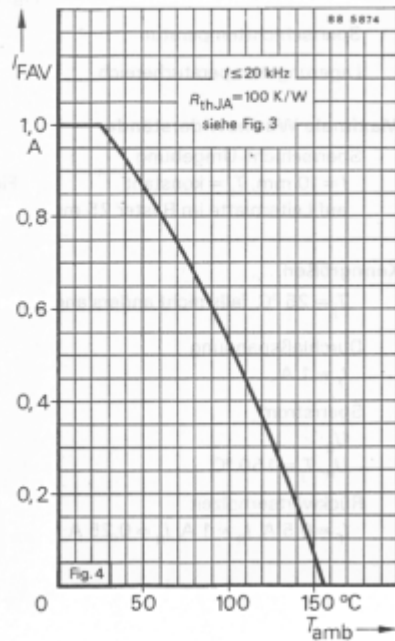
BYV 37 · BYV 38



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \leq 100 \text{ K/W}$

Fig.3

BB 2150



BYV 37 · BYV 38

